



BARRY

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ЧИП-КОМПОНЕНТЫ

Чип-компоненты – самые маленькие и дешевые компоненты. Идеально подходят для поверхностного монтажа

в собственных разработках заказчика:

- Номиналы резисторов в диапазоне от 0,1 Ом до 1,0 ГОм (размеры от 0.7 мм до 9.5 мм)
- Номиналы аттенюаторов от 0,25 дБ до 32 дБ
- Несколько вариантов металлизации
- Возможность выбора различных подложек
- Разнообразие резистивных конфигураций
- Варианты упаковки: лента и катушка типоразмеров 0402-3725
- Соответствуют требованиям ITAR, экологического стандарта RoHS и сертификата соответствия ISO9001:2000

Резисторы

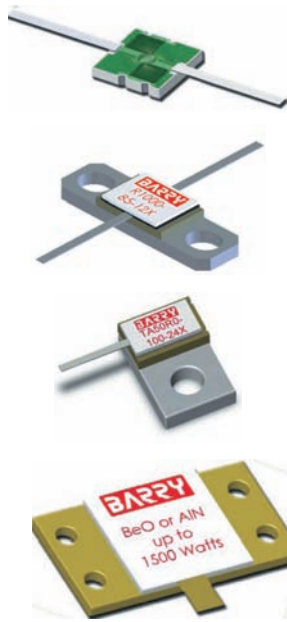
- Серия RP (Двойное напыление)
- Серия RK (4-х кратное напыление)
- Серия RM (Флип-чип, металлизированная стенка)
- Серия RS (Флип-чип, неметаллизированная стенка)

Оконечные нагрузки

- Серия TV/TVC (Частичное напыление)

Аттенюаторы

- Серия AP (Полное напыление)
- Серия AV/AVC (Частичное напыление)
- Серия АК (4-х стороннее напыление)
- Серия АТ/АТС (3-х стороннее напыление)
- Серия АМ (Флип-чип, металлизированная стенка)
- Серия АS (Флип-чип, неметаллизированная стенка)



МОЩНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компания выпускает:

- оконечные нагрузки
- резисторы
- аттенюаторы



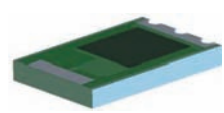
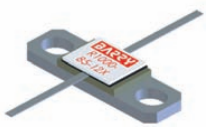




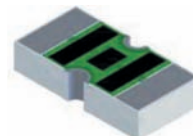
Высокомощные компоненты обеспечивают надежность при высоком уровне рассеиваемой мощности. Выпускаемая продукция характеризуется следующим:

- Номиналы резисторов в диапазоне от 0,1 Ом до 1 ГОм
- Номиналы аттенюаторов от 0,25 дБ до 32 дБ
- Доступна в различных конфигурациях
- Соответствует требованиям ITAR, экологическому стандарту RoHS и сертификату соответствия ISO9001:2000

Компания **Barry Industries** представляет широкий ряд мощных оконечных нагрузок и резисторов для поверхностного монтажа на BeO, AlN, а также импульсные мощные приборы, керамические корпуса и компоненты для авиационно-космической техники, СВЧ, полупроводниковых и оптоэлектронных устройств.

Компания Barry широко использует в производстве возможности LTCC технологий (www.barryltcc.com). Использование LTCC технологии позволяет производить широкий ассортимент изделий для различных применений, начиная от герметичных корпусов для СВЧ-компонентов до высокоинтегрированных гибридных модулей. Их функция – интеграция пассивных радиочастотных компонентов и герметичных полостей для активных полупроводниковых устройств на едином керамическом носителе.

Более подробную информацию смотрите на сайтах производителя
www.barryind.com, www.barryltcc.com, www.barryplating.com, www.semiconductorenclosures.com

	Исполнение	Подложка	Характеристики		
Оконечные нагрузки	Фланцевые	BeO	Мощность Частотный диапазон КСВН	10 Вт... 1500 Вт DC ... 6.0 ГГц 1.06 ... 1.50	
		Aluminum Nitride	Мощность Частотный диапазон КСВН	30 Вт... 800 Вт DC ... 4.5 ГГц 1.10 ... 1.30	
	Выводные	BeO	Мощность Частотный диапазон КСВН	20 Вт... 250 Вт DC ... 18.0 ГГц 1.15 ... 1.40	
		Aluminum Nitride	Мощность Частотный диапазон КСВН	10 Вт... 250 Вт DC ... 6.0 ГГц 1.10 ... 1.30	
	Чип	BeO	Мощность Частотный диапазон КСВН	20 Вт... 250 Вт DC ... 18.0 ГГц 1.15 ... 1.40	
		Aluminum Nitride	Мощность Частотный диапазон КСВН	10 Вт... 250 Вт DC ... 3.0 ГГц 1.10 ... 1.20	
Низко-емкостные резисторы	Фланцевые	BeO	Мощность Емкость при 1 МГц	20 Вт ... 200 Вт 0.7ΩΦ 2.15	
		Aluminum Nitride	Мощность Емкость при 1 МГц	20 Вт ... 100 Вт 0.73ΩΦ 1.73	
	Выводные	BeO	Мощность Емкость при 1 МГц	40 Вт ... 200 Вт 0.7ΩΦ 2.15	
		Aluminum Nitride	Мощность Емкость при 1 МГц	20 Вт ... 100 Вт 0.73ΩΦ 1.73	
	Чип	BeO	Мощность Емкость при 1 МГц	40 Вт ... 200 Вт 0.7ΩΦ 2.15	
		Aluminum Nitride	Мощность Емкость при 1 МГц	20 Вт ... 100 Вт 0.73ΩΦ 1.73	
Аттенюаторы	Фланцевые	BeO	Мощность Частотный диапазон КСВН Затухание	10 Вт... 250 Вт DC ... 4.0 ГГц 1.10 ... 1.25 1 ... 30 дБ	
		Aluminum Nitride	Мощность Частотный диапазон КСВН Затухание	10 Вт... 250 Вт DC ... 3.0 ГГц 1.10 ... 1.30 1 ... 30 дБ	
	Выводные	BeO	Мощность Частотный диапазон КСВН Затухание	10 Вт... 250 Вт DC ... 4.0 ГГц 1.25 ... 1.35 1 ... 30 дБ	
		Aluminum Nitride	Мощность Частотный диапазон КСВН Затухание	10 Вт... 250 Вт DC ... 3.0 ГГц 1.20 ... 1.30 1 ... 30 дБ	
	Чип	BeO	Мощность Частотный диапазон КСВН Затухание	10 Вт... 250 Вт DC ... 4.0 ГГц 1.25 ... 1.35 1 ... 30 дБ	
		Aluminum Nitride	Мощность Частотный диапазон КСВН Затухание	10 Вт... 250 Вт DC ... 3.0 ГГц 1.06 ... 1.30 1 ... 30 дБ	

Официальный представитель



Официальный дистрибьютор



Партнер



111024, Москва,
Авиамоторная ул., д. 8
Телефоны: (495) 957-7745
(495) 361-0416/0904
Факс: (495) 925-1064
e-mail: sales@radiocomp.ru

www.radiocomp.ru

Уникальные
радиокомпоненты
ведущих фирм мира
РАДИОКОМП®